




Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d'organisation et d'évaluation des unités d'enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront- communiquées par les enseignant-es aux étudiant-es.

5 crédits	30.0 h + 30.0 h	Q1
-----------	-----------------	----

Enseignants	Flandre Denis ;Janvier Danielle ;Oestges Claude ;
Langue d'enseignement	Français
Lieu du cours	Louvain-la-Neuve
Préalables	Ce cours suppose acquises les notions de base de physique de l'électricité et des ondes, telles qu'enseignées dans les cours LEPL1201 , LEPL1202 , LEPL1203 .
Thèmes abordés	Ce cours vise à identifier et mettre en oeuvre les lois de base de l'électromagnétisme (partie 1) et des dispositifs électroniques (partie 2) en vue de leurs applications dans les cours avancés des filières électricité, électromécanique ou physique appliquée.
Acquis d'apprentissage	<p>a. <u>Contribution de l'activité au référentiel AA (AA du programme)</u> Axe 1 (1.1, 1.2, 1.3), Axe 2 (2.2), Axe 3 (3.2)</p> <p>b. <u>A l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :</u></p> <p><u>Partie 1 : Electromagnétisme</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre en équation et résoudre de manière rigoureuse les problèmes électrostatiques et magnétostatiques comportant des distributions de charges et de courants de formes canoniques dans le vide, en précisant les hypothèses simplificatrices utilisées. • Mettre en équation les problèmes de calcul de champs électrostatiques et magnétostatiques dans et autour de structures diélectriques et magnétiques de permittivité et perméabilité connues et de formes canoniques, en appliquant adéquatement les conditions aux limites. • Calculer les résistances, inductances et capacités distribués de structures géométriques de formes simples. • Calculer les champs, forces et tensions induites dans un circuit magnétique. 1 • Calculer les champs électromagnétiques sur les lignes de transmission et utiliser leur circuit équivalent pour dimensionner des circuits d'adaptation d'impédance à l'aide de tronçons de ligne et d'éléments discrets en utilisant l'abaque de Smith. <p><u>Partie 2 : Dispositifs électroniques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier et décrire les mécanismes physiques du fonctionnement de la jonction PN, du transistor bipolaire et du transistor MOS de tailles microniques, • en dériver les modèles mathématiques de leurs caractéristiques électriques en régimes statiques et petits-signaux basse fréquence, • les représenter graphiquement, • comparer et discuter ces modèles avec des caractéristiques de dispositifs réels. <p><u>Acquis d'apprentissage transversaux :</u> Vérifier les unités des différentes variables et termes qui apparaissent dans les équations constitutives d'un modèle</p> <p>-----</p> <p><i>La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d'enseignement (UE) ».</i></p>
Modes d'évaluation des acquis des étudiants	<p>En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d'être modifiées. La partie "électromagnétisme" et la partie "dispositifs électroniques" comptent chacune pour la moitié de la note finale, sauf si une lacune importante est constatée dans une des deux parties.</p> <p>Un examen dispensatoire peut être organisé en novembre pour la partie "électromagnétisme" (exercices, avec un formulaire). Dans ce cas, les étudiants ayant obtenu plus de 12/20 à cet examen peuvent choisir de conserver ou non leur note (pour cette partie) pour les sessions de janvier et/ou août (cette note n'est cependant pas reportée à l'année académique suivante).</p> <p>L'évaluation de la partie dispositifs électroniques est constituée de l'examen écrit organisé en session, ainsi que de tests écrits éventuellement réalisés pendant le quadrimestre.</p>

Méthodes d'enseignement	<p>En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d'être modifiées. Le cours est organisé autour des cours théoriques et des séances d'exercices.</p> <p>Les enseignants privilégient la bonne connaissance des notions de base.</p> <p>Les exercices permettent d'apprendre à maîtriser la mise en oeuvre des équations de Maxwell pour la résolution de problèmes simples d'électromagnétisme.</p> <p>Dans la partie dispositifs électroniques, il s'agit de résoudre des problèmes simples de physique des semiconducteurs et des dispositifs de base.</p> <p>L'activité se donne en présentiel.</p>
Contenu	<p>Le cours contient les outils nécessaires à la résolution des problèmes d'électromagnétismes classiques et permet aux étudiants de mettre ces outils en pratique dans la résolution de problèmes simples. Une grande attention est portée à la démarche de modélisation de problèmes pratiques et à leur mise en équation. Les équations disponibles sont peu nombreuses, la difficulté réside principalement dans le choix de la forme des équations la plus adéquate (équations intégrales ou différentielles, coordonnées cartésiennes ou sphériques, etc.) pour le problème posé.</p> <p>La partie dispositifs électroniques utilise une démarche similaire. Les équations sont adaptées et simplifiées au cas des semiconducteurs. Sur cette base, la physique des dispositifs semiconducteurs principaux est mise en équation et les résultats confrontés à leurs caractéristiques réelles. Les conditions de validité des modèles simples, leurs limites et corrections de second ordre sont largement discutées.</p>
Ressources en ligne	<p>Moodle http://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id=7790</p>
Bibliographie	<p>Livre de référence pour la partie électromagnétisme : Engineering Electromagnetics, Hayt et Buck, McGraw Hill, 7e édition</p> <p>Notes sur Moodle pour les dispositifs électroniques. Quelques livres de référence sont disponibles à la BST :</p> <p>« Physique des dispositifs semi-conducteurs », De Boeck Université, J.-P. Colinge et F. Van de Wiele</p> <p>« Operation and modeling of the MOS transistor », Y. P. Tsividis, McGraw-Hill Book Company.</p> <p>"Physics of semiconductor devices", S. M. Sze, Wiley.</p>
Faculté ou entité en charge:	ELEC

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)				
Intitulé du programme	Sigle	Crédits	Prérequis	Acquis d'apprentissage
Master [120] : ingénieur civil physicien	FYAP2M	5		
Mineure en sciences de l'ingénieur: électricité (accessible uniquement pour réinscription)	LELEC100I	5		
Mineure en Electricité	LFSA133I	5		
Filière en Electricité	LELEC100P	5		